

CMPD2003	CMPD2004
CMPD2003A	CMPD2004A
CMPD2003C	CMPD2004C
CMPD2003S	CMPD2004S

**SURFACE MOUNT  
HIGH VOLTAGE  
SILICON SWITCHING DIODE**



**SOT-23 CASE**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPD2003, CMPD2003A, CMPD2003C, CMPD2003S, CMPD2004, CMPD2004A, CMPD2004C and CMPD2004S types are silicon switching diodes manufactured by the epitaxial planar process, designed for applications requiring high voltage capability.

The following configurations are available:

<b>CMPD2003</b>	SINGLE
<b>CMPD2003A</b>	DUAL, COMMON ANODE
<b>CMPD2003C</b>	DUAL, COMMON CATHODE
<b>CMPD2003S</b>	DUAL, IN SERIES
<b>CMPD2004</b>	SINGLE
<b>CMPD2004A</b>	DUAL, COMMON ANODE
<b>CMPD2004C</b>	DUAL, COMMON CATHODE
<b>CMPD2004S</b>	DUAL, IN SERIES

<b>MARKING CODE: A82</b>
<b>MARKING CODE: 8A2</b>
<b>MARKING CODE: C3C</b>
<b>MARKING CODE: C3S</b>
<b>MARKING CODE: D53</b>
<b>MARKING CODE: DB8</b>
<b>MARKING CODE: DB7</b>
<b>MARKING CODE: DB6</b>

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

Continuous Reverse Voltage
Peak Repetitive Reverse Voltage
Average Forward Current
Continuous Forward Current
Peak Repetitive Forward Current
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\mu\text{s}$
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\text{s}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL	CMPD2003	CMPD2004	UNITS
	CMPD2003A	CMPD2004A	
	CMPD2003C	CMPD2004C	
	CMPD2003S	CMPD2004S	
$V_R$	200	240	V
$V_{RRM}$	250	300	V
$I_O$	200	200	mA
$I_F$	250	225	mA
$I_{FRM}$		625	mA
$I_{FSM}$		4.0	A
$I_{FSM}$		1.0	A
$P_D$		350	mW
$T_J, T_{stg}$		-65 to +150	$^\circ\text{C}$
$\theta_{JA}$		357	$^\circ\text{C/W}$

CMPD2003    CMPD2004  
 CMPD2003A    CMPD2004A  
 CMPD2003C    CMPD2004C  
 CMPD2003S    CMPD2004S

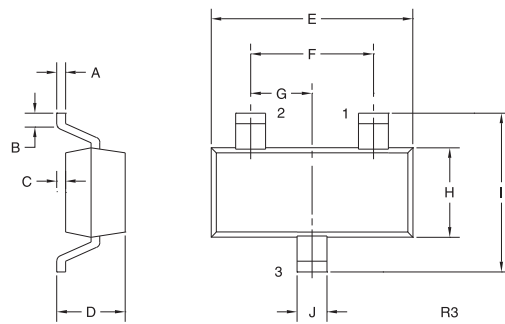


**SURFACE MOUNT  
 HIGH VOLTAGE  
 SILICON SWITCHING DIODE**

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	CMPD2003		CMPD2004		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	
$I_R$	$V_R=200\text{V}$	-	100	-	-	nA
$I_R$	$V_R=200\text{V}, T_A=150^\circ\text{C}$	-	100	-	-	$\mu\text{A}$
$I_R$	$V_R=240\text{V}$	-	-	-	100	nA
$I_R$	$V_R=240\text{V}, T_A=150^\circ\text{C}$	-	-	-	100	$\mu\text{A}$
$BV_R$	$I_R=100\mu\text{A}$	250	-	300	-	V
$V_F$	$I_F=100\text{mA}$	-	1.0	-	1.0	V
$V_F$	$I_F=200\text{mA}$	-	1.25	-	-	V
$C_T$	$V_R=0, f=1.0\text{MHz}$	-	5.0	-	5.0	pF
$t_{rr}$	$I_R=I_F=30\text{mA}, R_L=100\Omega, \text{Rec. to } 3.0\text{mA}$	-	50	-	50	ns

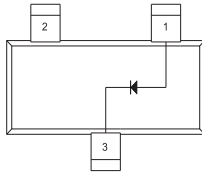
**SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE**



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

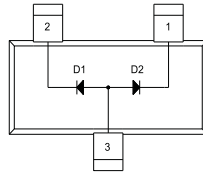
**PIN CONFIGURATIONS**



**CMPD2003  
 CMPD2004**

**LEAD CODE:**

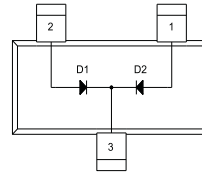
- 1) Anode
- 2) No Connection
- 3) Cathode



**CMPD2003A  
 CMPD2004A**

**LEAD CODE:**

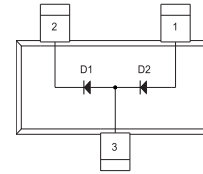
- 1) Cathode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, D2



**CMPD2003C  
 CMPD2004C**

**LEAD CODE:**

- 1) Anode D2
- 2) Anode D1
- 3) Cathode D1, D2



**CMPD2003S  
 CMPD2004S**

**LEAD CODE:**

- 1) Anode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Cathode D2

**MARKING CODE: SEE PREVIOUS PAGE**

R9 (25-January 2010)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9